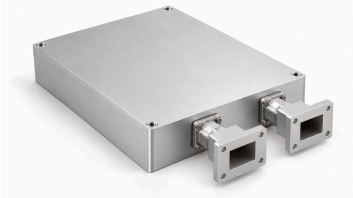
10700–12750 MHz GaN RFパワーアンプ、標準100 W、WR75アダプタ



GaNアンプは10700–12750 MHzで標準飽和出力100 W、最小利得50 dBを備えます。1 dB圧縮点の標準出力は40 W、100 W時の標準電流は21 Aです。

寸法は筐体を示します。出力アダプタと取り付け部の突起を含む設置外形は LCRF にご確認ください。 RF 入力は SMA、出力は N-K から WR75 導波管への変換アダプタを使用します。SW は Low で CH1、High で CH2 を選択し、切り替え時間は 15 ms 未満です。温度と電流のアナログ検出に対応します。 配線または電源投入前に、ピン 5 の機能を LCRF にご確認ください。

電気仕様 +28.0VDC; 25°C; 50Ω

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
動作周波数	BW	10700	-	12750	MHz
1 dB圧縮点出力電力	P-1dB	-	40	-	W
RF出力電力 @ PSAT	PSAT	-	100	-	W
電力利得 @ PSAT	Gp	50	-	-	dB
電力利得平坦度 @ PSAT	ΔGp	-	±1	-	dB
入力リターンロス	S11	-	-15	-	dB
100 W 時の高調波	H	-	-20	-	dBc
スプリアス信号 @ PSAT	Spur	-	-60	-	dBc
入出力インピーダンス	Impedance	-	50	-	Ω
動作電圧	VDC	-	28	-	VDC
電力付加効率 @ 100W	Eff	-	25	-	%
DC電流 @ 100W	IDD	-	21	-	A

絶対最大定格

項目	定格
損傷を生じない RF 入力電力	+10 dBm 最大
Pout = 100 W 時の負荷 VSWR	∞; 全負荷位相・振幅、連続
熱過負荷	85 °C → 停止 (最大)

環境仕様

記載の環境条件は設計目標値です。ご使用の案件に適用される条件を確認してください。

項目	最小値	代表値	最大値	単位
動作温度	-20	-	50	°C
保存温度 [1]	-25	-	65	°C
相対湿度（結露なし）	-	-	95	%

[1] 保存温度

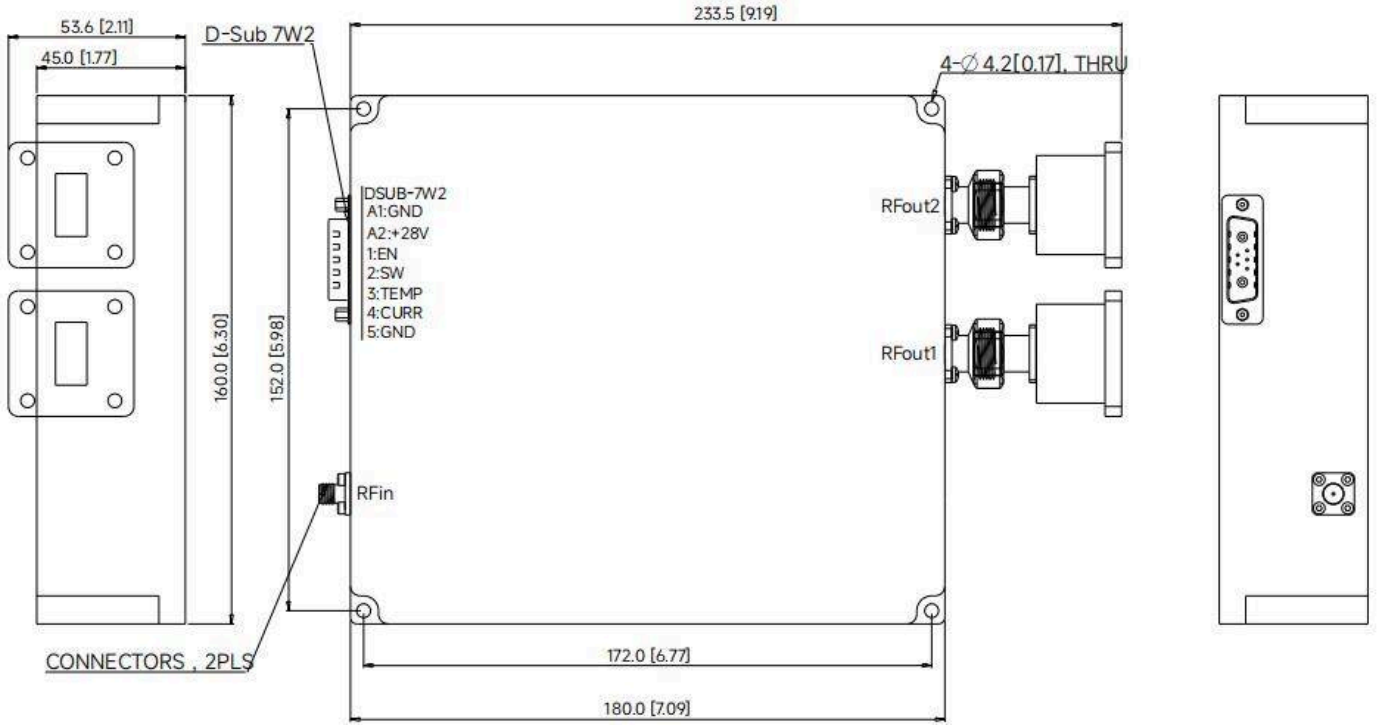
DC および制御インターフェース

ピン番号	説明	仕様
A1	A1 — グラウンド	グラウンド
A2	A2 — 電源正極	+28V
1	1 — イネーブル	TTLハイレベル（3.3 V）、内部プルダウン
2	2 — RFチャネル選択（SW）	CH1: ローレベル; CH2: ハイレベル; <15 ms
3	3 — 温度検出出力	750 ±20 mV @25 °C; 10 mV/°C
4	4 — 電流検出出力	100 mV/A

機械仕様

寸法は筐体を示します。出力アダプタと取り付け部の突起を含む設置外形は LCRF にご確認ください。

項目	値	単位
本体寸法	180 × 160 × 45 mm (寸法は筐体を示します。出力アダプタと取り付け部の突起を含む設置外形は LCRF にご確認ください。)	mm
質量	2.5 kg (最大)	kg
RF 入力コネクタ	SMA, メス	-
RF 出力コネクタ	N-K → WR75 導波管アダプタ	-
DC／制御インターフェース	ハイブリッド, D-Sub 7, オス	-



現在の発行記録 · 1.5 · 2026-11-12. 仕様表の内容を更新しました。 置き換え対象の改訂版 1.4.

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。